**NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI AC/DC DOUBLE BOOST 5 MỨC   
KHI CÓ SỰ CỐ VAN BÁN DẪN CÔNG SUẤT**

ANALYSIS AND SIMULATION OF FIVE - LEVEL AC/DC DOUBLE BOOST CONVERTER WITH FAULT SEMICONDUCTOR DEVICES

**Phạm Thị Thùy Linh**

Trường Đại học Điện lực

Ngày nhận bài: 25/10/2018, Ngày chấp nhận đăng: 20/12/2018, Phản biện: TS. Nguyễn Lê Cường

**Tóm tắt:**

Bài báo tập trung phân tích khả năng chịu lỗi của sơ đồ Double- Boost năm mức, khi có hiện tượng hư hỏng van bán dẫn trong mạch, qua đó khẳng định khả năng làm việc liên tục sau sự cố của bộ biến đổi, ngoài các ưu điểm vượt trội đã biết của sơ đồ bộ biến đổi đa mức. Trong bài báo này, tác giả đã tính toán và xây dựng mô hình điện và nhiệt của các phần tử bán dẫn công suất để kiểm chứng khả năng mang tải sau sự cố của các van bán dẫn công suất. Mạch phát hiện sự cố cũng được tác giả thiết kế và mô phỏng. Cuối cùng mô hình mô phỏng sơ đồ Double Boost năm mức vận hành bình thường và sự cố đã được thực hiện trên phần mềm chuyên dụng PSIM và đã kiểm chứng tốt nghiên cứu của tác giả.

**Từ khóa:**

Khả năng chịu lỗi,bộ biến đổi tĩnh, điều chế độ rộng xung, bộ biến đổi đa mức.

**Abstract**:

The article focuses on the fault tolerance of a five- level Double-Boost converter, where a failure appears on the semiconductor device, thereby confirming the possibility of non-stop operation after fault, supplement advantage behavior besides many advantages of multilevel converters. This paper has calculated and modeled the electrical and thermal models of power semiconductors to verify the load carrying capability of the power semiconductor devices in the abnormal case. The fault detection circuit is also designed and simulated. Lastly, the simulation of the five- level Double Boost converter with electrical and thermal models in normal and fault operation was realized on the PSIM software to verify the work.

**Keywords**:

Fault tolerant,Static converter, Pulse Width Modulation, Multilevel converter.

**1. MỞ ĐẦU**

Ngày nay, phần lớn các hệ thống năng lượng điện sử dụng các bộ biến đổi đa mức để có được điện năng hiệu suất cao. Các hệ thống này cũng phải làm việc tin cậy, an toàn, liên tục trong suốt thời gian làm việc thậm chí cả khi có lỗi hư hỏng xuất hiện trong một hay nhiều phần tử của mạch công suất. Yêu cầu về độ tin cậy này có được một mặt là nhờ công nghệ van bán dẫn, một mặt nhờ thiết kế các cấu trúc sơ đồ mới đáp ứng được yêu cầu như trên. Ta biết rằng các sơ đồ chỉnh lưu được sử dụng như là giao diện giữa lưới xoay chiều AC và tải một chiều DC. Không giống như các sơ đồ chỉnh lưu truyền thống (sơ đồ chỉnh lưu cầu, tia…) sử dụng điôt hay thyristor làm méo dạng tín hiệu nguồn và có lượng sóng hài rất cao. Chính vì vậy có rất nhiều nghiên cứu để cải thiện chất lượng điện năng của các bộ chỉnh lưu AC/DC [1-3]. Trong bài báo này, tác giả đề cập đến cấu trúc sơ đồ năm mức PFC cho phép cải thiện thành phần sóng hài của dòng điện xoay chiều để có được hệ số công suất gần 1 và tăng mức điện áp DC ở giá trị lớn hơn điện áp AC [4], kết quả ở [4] rất khả quan cho thấy khi bị sự cố sơ đồ sẽ chuyển sang cấu trúc bốn mức thay vì năm mức, tuy nhiên để đảm bảo khả năng làm việc sau sự cố của sơ đồ thì tác giả sẽ nghiên cứu trạng thái làm việc sau sự cố, tình trạng van bán dẫn, khả năng tăng nhiệt để đảm bảo sự làm việc bền vững của các van bán dẫn cũng như cả cấu trúc mạch trong trạng thái sự cố. Tác giả sẽ trình bày hoạt động của sơ đồ, cùng với phương pháp điều khiển PWM (Pulse Width Modulation), đề xuất mô hình nhiệt và mô hình điện, thiết kế sơ đồ mạch phát hiện lỗi hư hỏng van ở dạng tổng trở thấp trên cơ sở đó thực hiện tính toán và mô phỏng hoạt động của sơ đồ trong chế độ vận hành bình thường và sự cố van công suất. Trong nghiên cứu này, mạch mô phỏng được thực hiện với phần điều khiển bao gồm một mạch điều khiển dòng điện đầu vào và ba mạch điều khiển điện áp đầu ra. Mạch điều khiển dòng điện cho phép giảm méo dòng diện và nâng cao hệ số công suất của bộ biến đổi. Phân tích nguyên lý và kết quả mô phỏng bộ biến đổi trong chế độ làm việc bình thường bằng phần mềm PSIM được trình bày trong phần 2. Van bán dẫn có điều khiển là thành phần xung yếu nhất vì thế kết quả nghiên cứu mô hình nhiệt được thực hiện và trình bày trong phần 3 để kiểm tra khả năng mang tải khi hư hỏng của các van. Phần 4 trình bày sơ đồ thiết kế và mô hình mô phỏng mạch phát hiện lỗi van transisto và điôt. Các kết quả phân tích hoạt động của sơ đồ trong chế độ làm việc bình thường và sự cố ứng với hai dạng sự cố điển hình trên transitor và điôt được trình bày trong phần 5 và cuối cùng phần 6 là kết luận chung của toàn bộ nghiên cứu.

2. SƠ ĐỒ DOUBLE- BOOST 5 MỨC   
VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

Sơ đồ Double Boost 5 mức (hình 1) mở rộng từ sơ đồ Double Boost (DB) 3 mức được nghiên cứu nhiều ở mức trung áp bởi vì ưu điểm mở rộng trực tiếp sang sơ đồ ba pha, mật độ tổn thất thấp, điện áp định mức của các van bán dẫn giảm một nửa so với sơ đồ 3 mức cùng công suất trong chế độ làm việc bình thường và đặc biệt nó cải thiện THD của điện áp vào mạch. Sơ đồ 5 mức DB gồm 4 nhóm chuyển mạch, trong cấu trúc của nó có thêm một tụ nổi cho việc dẫn dòng dương và một tụ nổi cho việc dẫn dòng âm. Ở đây tác giả lựa chọn van bán dẫn có điều khiển 600 V (MOS APT60N60BCSG) cho điện áp bus DC 800V để các van có thể chịu được điện áp khi có sự cố trong mạch. Các van bán dẫn trong sơ đồ thiết kế và các thông số chính được trình bày trong bảng 1. Tuy nhiên, các tụ nổi được thiết kế với điện áp VDC/2 và duy trì công suất trong một nửa chu kì tần số xoay chiều. Ở đây tác giả đặc biệt quan tâm đến việc điều khiển ở tần số cao, khi tần số chuyển mạch Fsw lớn hơn 20 kHz, thì sẽ giá trị tụ sẽ giảm qua đó giảm năng lượng tích trữ cũng như giá thành của mạch, dòng điện hiệu dụng nhỏ (ví dụ 20 µF- 40 mJ/A đối với điện áp 200 V).



Hình 1. Sơ đồ Double Boost 5 mức (230VAC-400 Hz / 800 V DC; Fsw= 40 kHz)



Hình 2. Nguyên lý điều chế của mạch Double Boost 5 mức



Hình 3. Các dạng sóng điện áp và dòng điện chính của mạch Double Boost 5 mức

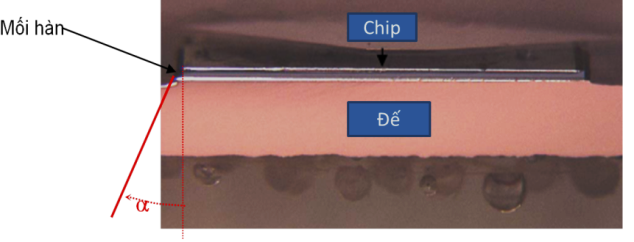
Nguyên lý điều chế và các dạng sóng điện áp Vinput 5 mức, điện áp nguồn vào xoay chiều VAC và dòng điện đầu vào IL có dạng sin mà không cần đến bộ lọc đầu vào được trình bày ở hình 2 và 3.

Bảng 1. Các thông số chính của van

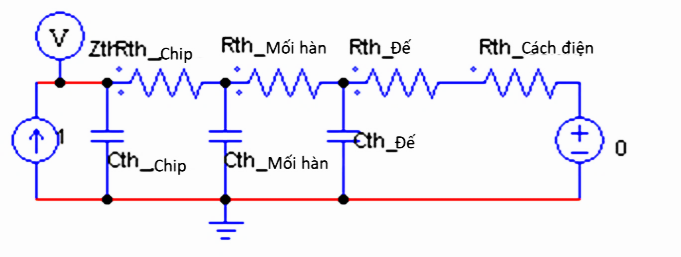
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên van bán dẫn | RDSON [mΩ]  125°C | Vdo [mV] 125°C | Rd[mΩ]  125°C |
| Transitor Mos APT60N60BCSG | 57 | 625 | 170 |
| Điôt SiC Schottky 600V GP2DO20A060B |  | 800 | 41 |
| Điôt chỉnh lưu 600V APT30DS60B |  | 1000 | 35,7 |

3. MÔ HÌNH NHIỆT CỦA TRANSISTO MOS VÀ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ CỦA VAN BÁN DẪN Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP

Mô hình nhiệt (hình 5) của transisto MOS được tác giả đề xuất sau đây theo sự phân tích van bán dẫn đến từ công ty SEPHA (hình 4), điện trở và tụ của mỗi lớp thể hiện cấu tạo của Transitor MOS APT60N60BCSG.

**

Hình 4. Cấu tạo của Transitor Mos APT60N60BCSG



Hình 5. Mô hình nhiệt của Transitor Mos APT60N60BCSG

Giả thiết rằng sự truyền sóng của dòng năng lượng theo hướng hình tháp (hình 6), điều đó sẽ cho phép tính toán các điện trở nhiệt và các tụ nhiệt ở mỗi lớp, ta có phương trình cơ bản sau:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (1) |

Trong đó:

*λ* : độ dẫn nhiệt của mỗi lớp;

*ρ* : năng lượng khối của mỗi lớp;

*Cp* : nhiệt khối của mỗi lớp;

*S* : mặt cắt của mỗi lớp.

Với: 

*α* : góc không đổi ≈45°

|  |  |
| --- | --- |
|  | (2) |

Như vậy ta có:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (3) |



Hình 6. Sơ đồ tái cấu trúc các kích thước   
của mỗi lớp cấu tạo của transisto Mos

Cuối cùng ta có được kết quả tính toán của điện trở và tụ nhiệt theo các công thức (4) và (5) như sau:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4) |

Và:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (5) |

Ta có kết quả tính toán các thông số của mô hình ở hình 5 được thể hiện ở bảng 2.

Tác giả thực hiện mô phỏng sơ đồ cấu trúc Double- Boost 5 mức với mô hình điện và nhiệt. Kết quả mô phỏng thể hiện trên bảng 3 đã khẳng định rằng các van bán dẫn có thể tiếp tục làm việc với một sự tăng nhiệt độ chấp nhận được. Và van bán dẫn kề cận van bị lỗi sẽ phải chịu sự tăng nhiệt độ hơn, các phần tử trong nhóm chuyển mạch không bị lỗi sẽ phải chịu gấp đôi điện áp cho nên tổn thất khi chuyển mạch ít nhất sẽ bị tăng gấp đôi.

Bảng 2. Tổng hợp các kết quả tính toán   
điện trở nhiệt và tụ nhiệt của transisto Mos APT60N60BCSG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rth[K/W] | Cth [J/K] |
| Độ dày của chip 165 µm | 1,602.10-2 | 1,847.10-2 |
| Độ dày mối hàn 74 µm | 2,35.10-2 | 6,984.10-3 |
| Độ dày đế  1,85 µm | 4,487.10-2 | 6,862.10-1 |

Bảng 3. Nhiệt độ chip của Mos h\_p (ΔTchip1)   
và nhiệt độ chip của Mos b\_p (ΔTchip2)   
khi có sự cố xuất hiện trên Mos h\_p

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sự cố trên Mos Mh\_p | | | | |
| Cf [µF] | Điện trở sự cố [Ω] | ΔTchip1 | | ΔTchip2 |
| Quá độ | Xác lập |
| 40 | 0,.1 | 5 | 3 | 27 |
| 0,5 | 12 | 4 | 27 |
| 70 | 0,1 | 7 | 2 | 27 |
| 0,5 | 18 | 4 | 27 |

Kết quả đạt được ở bảng 3 và 4 được giải thích như sau: năng lượng tích lũy trong tụ Cf càng lớn, thì sự tăng nhiệt độ trong transisto MOS Mh\_p càng mạnh. Đặc biệt trong trường hợp sự cố của điôt ta thấy rằng : điện trở van sự cố càng lớn thì điện áp đặt lên transisto Mos Mh\_p càng giảm và nhiệt độ van càng nhỏ. Do vậy giải pháp ở đây của tác giả là giảm thiểu giá trị của tụ *Cf*đó chính là lí do vì sao tác giả điều khiển mạch ở tần số cao.

Bảng 4. Nhiệt độ chip của MOS h\_p (ΔTchip1) và nhiệt độ chip của MOS b\_p (ΔTchip2)   
khi có sự cố xuất hiện trên điôt Dh\_p

\* : trường hợp Mos được điều khiển ON sau sự cố nhờ bộ phát hiện lỗi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sự cố trên điôt Dh\_p | | | | | | | |
| Cf  [µF] | Điện trở sự cố [Ω] | ΔTchip1 | | | | ΔTchip2 | ΔTchip2\* |
| Quá độ | Quá độ\* | Xác lập | Xác lập\* |
| 40 | 0,1 | 38 | 33 | 6 | 4 | 26 | 25 |
| 0,5 | 17 | 14 | 5 | 4 | 26 | 25 |
| 70 | 0,1 | 62 | 58 | 6 | 5 | 27 | 25 |
| 0,5 | 26 | 22 | 5 | 4 | 27 | 25 |

4. THIẾT KẾ MẠCH PHÁT HIỆN SỰ CỐ VÀ MÔ PHỎNG TRÊN PSIM

4.1. Mạch phát hiện lỗi khi xuất hiện sự cố trên transisto Mos

Nguyên lý vận hành của mạch phát hiện sự cố khi có một lỗi hư hỏng trên transisto Mos dựa vào việc phát hiện không có điện áp trên van khi mà xuất hiện tín hiệu điều khiển khóa van. Để mạch tin cậy, bộ phát hiện lỗi sẽ tác động sau khoảng thời gian Δt (5µs) (hình 7). Mô hình mô phỏng thực hiện trên PSIM được thể hiện ở hình 9.



Hình 7. Nguyên lý vận hành của mạch phát hiện sự cố transitor MOS

4.2. Mạch phát hiện lỗi khi xuất hiện sự cố trên điôt

Nguyên lý vận hành của mạch phát hiện sự cố khi có một lỗi hư hỏng trên điôt dựa vào việc tại thời điểm mở van transisto Mos: điện áp ở hai đầu của van Mos phải giảm về xấp xỉ không (IcRdson), trong trường hợp ngược lại điện áp này bằng với điện áp của nhóm chuyển mạch (dòng bão hòa Ipot chế ngự), có nghĩa rằng có một lỗi hư hỏng tổng trở thấp xuất hiện trong điôt (hình 8).

Để mạch tin cậy, bộ phát hiện lỗi sẽ tác động sau khoảng thời gian Δt (5µs). Mô hình mô phỏng thực hiện trên PSIM được thể hiện ở hình 9.



Hình 8. Nguyên lý vận hành của mạch   
phát hiện sự cố điôt

Mô hình mô phỏng mạch phát hiện sự cố được thực hiện trên PSIM như sau:



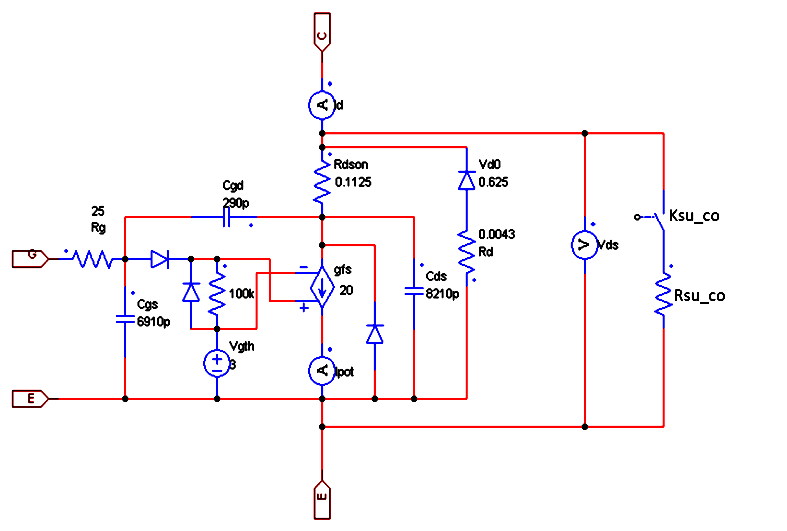
Hình 9. Mô phỏng mạch phát hiện lỗi transisto Mos và điôt trên phần mềm PSIM

5. PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA SƠ ĐỒ DOUBLE- BOOST 5 MỨC KHI XUẤT HIỆN LỖI HƯ HỎNG CỦA TRANSISTO VÀ ĐIÔT

Dựa trên các kết quả nghiên cứu ở [5-6], phần này tác giả nghiên cứu và phân tích các dạng sóng và các ràng buộc của bộ biến đổi công suất Double-Boost năm mức để khẳng định nó có thể tiếp tục vận hành khi có lỗi điều khiển hoặc lỗi vật lý transisto và điôt.

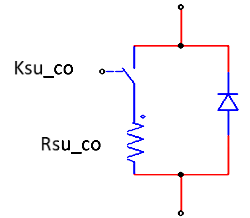
5.1. Mô phỏng mô hình điện của van bán dẫn trong trường hợp sự cố

Mô hình mô phỏng điện của transitor MOS APT60N60BCSG được tác giả đề xuất trên hình 10.



Hình 10. Mô hình các thành phần của Transisto MOS khi có sự cố

Trong trường hợp hư hỏng vật lý của Transisto Mos, một điện trở có giá trị nhỏ được kết nối song song trong mô hình mô phỏng (hình 10) , tương tự như vậy ta có mô hình vật lý của điôt trong trường hợp sự cố như sau (hình 11):



Hình 11. Mô hình các thành phần của điôt   
khi có sự cố

5.1. Mô phỏng trạng thái hoạt động   
của mạch PFC DB 5 mức ứng   
với trường hợp có lỗi xuất hiện   
trên transisto MOS

Nếu Mh\_p hư hỏng ở dạng điện trở thấp, điôt kết hợp với transisto trong cùng một nhóm chuyển mạch sẽ bị khóa cho đến khi điện áp ở hai đầu tụ *Cf*1 còn dương. Nhóm chuyển mạch này sẽ không hoạt động nữa và trong tụ sẽ xuất hiện dòng điện một chiều âm làm phóng điện tụ (chuyển ngược năng lượng về nguồn). Đến thời điểm phóng điện hoàn toàn, bộ biến đổi chuyển hoàn toàn từ 5 mức xuống 4 mức (hình 12). Transisto bị sự cố mắc nối tiếp với Mb\_p, nó sẽ có cùng dòng điện chạy qua và có tổn thất nhiệt, trừ có một dao động nhỏ xuất hiện do có một mạch vòng kí sinh “nạp- phóng” năng lượng nhỏ của *Cf*1 (hình 13).Việc phóng điện Cf1 làm tăng gấp đôi điện áp trên nhóm chuyển mạch thứ 2, việc này được chấp nhận bởi vì trong thiết kế đã chọn các linh kiện bán dẫn có điện áp định mức 600 V đối với điện áp bus một chiều là 800 V. Các linh kiện bán dẫn hoạt động bình thường ở nửa chu kì âm của dòng điện lưới và trong thiết kế của sơ đồ khi sự cố xảy ra đến nhóm chuyển mạch 1 thì nhóm chuyển mạch 3 và 4 không bị ảnh hưởng gì. Đó là một điểm mạnh nổi bật của sơ đồ Double-Boost 5 mức.



Hình 12. Kết quả mô phỏng các tín hiệu điện áp, dòng điện   
và tín hiệu điều chế của sơ đồ Double Boost khi có sự cố trên transisto MOS



Hình 13. Kết quả mô phỏng các tín hiệu điện áp, dòng điện   
và tín hiệu điều chế của sơ đồ PFC Double Boost khi có sự cố trên transisto MOS Mh\_p: Zoom hoạt động của mạch khi điện áp tụ nổi 1 Vcf1≈ 0

5.2. Mô phỏng trạng thái hoạt động   
của mạch PFC DB 5 mức ứng với trường hợp có lỗi xuất hiện trên điôt

Ta giả thiết rằng khi có lỗi vật lý của điôt, điôt này sẽ hư hỏng ở dạng điện trở thấp.

Vào thời điểm sự cố, transisto MOS bị ngắn mạch cùng với tụ *Cf*1 và dòng điện trong transisto MOS bão hòa ở dòng Ipot gây ra phóng điện rất nhanh của tụ Cf1, điện áp chuyển từ 5 mức thành 4 mức (hình 14).



Hình 14. Kết quả mô phỏng các tín hiệu điện áp, dòng điện của sơ đồ Double Boost   
khi có sự cố trên điôt Dh\_p

Như vậy, trong trường hợp lỗi hư hỏng vật lý của transisto: transisto bị lỗi sẽ chịu dòng điện dẫn và dòng điện chuyển mạch của transisto lân cận được mắc nối tiếp, được lọc theo hiệu ứng Snubber có từ *Cf*1. Cho nên trong phần tiếp theo tác giả sẽ tính toán đánh giá tổn thất dự thừa trên transisto bị lỗi, từ đó đánh giá được đặc tính hoạt động theo thời gian.

Còn trong trường hợp lỗi vật lý của điôt: trong một nhóm chuyển mạch có van bị hỏng, transisto giới hạn dòng điện phóng của tụ nhưng sẽ áp một khoảng quá tải do mạch vòng dư nạp - phóng của tải trên tụ. Chính vì vậy tác giả đã đề xuất điều khiển giữ trạng thái dẫn của transisto bởi bộ phát hiện lỗi khi có sự cố trên điôt.

5. KẾT LUẬN

Bài báo đã phân tích trạng thái làm việc bình thường và sự cố của sơ đồ Double- Boost 5 mức. Từ cấu tạo của linh kiện transisto Mos APT60N60BCSG và kết quả phân tích đến từ công ty SEPHA tác giả đã xây dựng mô hình nhiệt và kiểm tra nhiệt độ của van bán dẫn ở chế độ xác lập, qua đó cho thấy với mạch tiêu chuẩn   
4 kW; 230VAC/800 VDC, các van bán dẫn hoàn toàn tiếp tục làm việc được sau sự cố với một sự tăng nhẹ nhiệt độ chấp nhận được. Tác giả cũng xây dựng được nguyên lý mạch phát hiện lỗi và mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng chuyên dụng PSIM. Mô hình mô phỏng cuối cùng để kiểm tra các đặc tính hoạt động của mạch Double - Boost 5 mức được thực hiện với mô hình điện của transisto Mos và điôt được tác giả sử dụng công cụ PSIM. Bài báo đã chỉ ra rằng, với sự cố của các van bán dẫn chuyển mạch, là nơi xung yếu nhất của mạch điện tử công suất thì bộ biến đổi DB 5 mức vẫn chấp nhận sự cố đầu tiên xảy ra trong mạch và tiếp tục hoạt động với toàn bộ công suất mà không cần tới một sự tác động bên ngoài nào về phía mạch lực, qua đó khẳng định tính tin cậy và khả năng dự phòng sau sự cố của sơ đồ công suất. Hướng tiếp theo của tác giả sẽ là mở rộng sơ đồ lên các mức cao hơn và chuyển từ mô phỏng tương tự sang mô phỏng số.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Le Claire J.C, Radouane A., Ginot N., Moreau R., “Simple Topology and Current Control for Fast AC/DC Converter with Unity Power Factor”, 11th International Power Electronics and Motion Control Conference, Riga, Latvia, 2-4 September 2004, CDROM ref. ISBN 9984-32-010-3.
2. B. Singh, K. Al Haddad, A. Pandey, D. P. Kothari, “A Review of Single-Phase Improved Power Quality AC/DC Converters”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.50, N°5, pp 962-981, October 2003.
3. M.L. Heldwein, M.S. Ortmann, S.A. Amusa,“Single-phase PWM Boost-type Unidirectional  
   Rectifier Doubling the Switching Frequency”, 13thEuropean Conference on Power Electronics and  
   Applications, EPE 2009, Sept. 8-10, Barcelona, Spain, 2009.
4. L. Pham, F. Richardeau, H. Helali, G. Gateau, M. Cousineau, M. Iturriz, '5-level Double-Boost PFC with Fault-Tolerant Capability', 13th European Power Electronic Conf., Barcelona, Spain , 2009.
5. Hui Liu, Ke Ma, Chao Wang & Frede Blaabjerg (2016) Fault Diagnosis and Fault-tolerant Control of Modular Multi-level Converter High-voltage DC System: A Review, Electric Power Components and Systems, 44:16, 1759-1785, DOI: 10.1080/15325008.2016.1198439.
6. Thi Thuy Linh Pham; Richardeau, F.; Gateau, G. ‘Real-Time Monitoring for a Five-Level Double-Boost Power Factor Controller Including Postfault Reconfiguration’, Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Page(s): 4128 - 4135 Volume: 60, Issue: 9, Sept. 2013.

Giới thiệu tác giả:

Tác giả Phạm Thị Thùy Linh nhận bằng Thạc sĩ tại Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia ENSEEIHT (Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Hydraulique de Toulouse), Toulouse, Cộng hòa Pháp vào năm 2008; nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Kỹ thuật Toulouse (Institut National Polytechnique de Toulouse) Cộng hòa Pháp vào năm 2011.

Tác giả hiện là giảng viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa - Trường Đại học   
Điện lực.

Lĩnh vực nghiên cứu: các bộ biến đổi đa mức, điều khiển số và chẩn đoán lỗi.